

БКО.348.348-02 ТУ

K558PP2A
K558PP2B**16К (2Кх8) РЕПРОГРАММИРУЕМОЕ ПЗУ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТИРАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ***NМОП технология*

Репрограммируемое постоянное запоминающее устройство предназначено для построения энергонезависимой памяти микро-ЭВМ, систем промышленной автоматики, связи и измерительной техники.

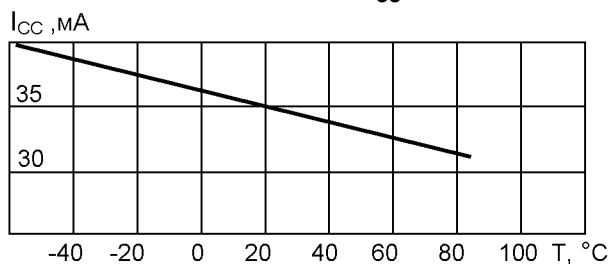
- время выборки адреса 350нс;
- напряжение питания 5В ± 5%;
- напряжение сигнала записи-стирания 25В ± 0,5В;
- допустимое значение статического потенциала не более 200В.

**НАДЕЖНОСТЬ**

| | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| Наработка, ч | $t_{и}$ | 50 000 |
| Интенсивность отказов 1/ч | $\lambda_{и}$ | $1 \cdot 10^{-6}$ |
| Срок хранения, лет | $t_{хр}$ | 12 |

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1- 8, 19, 22, 23 | A7-A0, A10-A8 | Вход адресный |
| 12 | OV | Общий |
| 9-11, 13-17 | D0 -D7 | Вход-выход данных |
| 18 | \overline{CE} | Вход сигнала разрешения обращения |
| 20 | \overline{OE} | Вход сигнала разрешения выхода |
| 21 | WR/ERA | Вход сигнала записи-стирания |
| 24 | U_{CC} | Источник питания |

ТИПОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ I_{CC} от T**ДОПУСТИМЫЕ ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ****МЕХАНИЧЕСКИЕ**

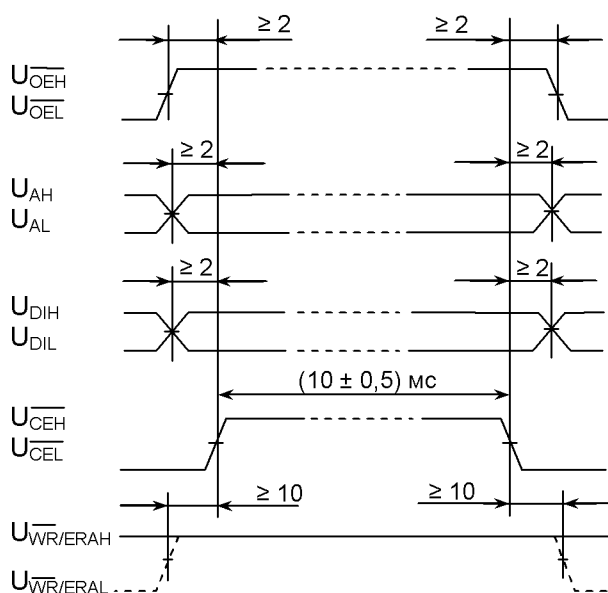
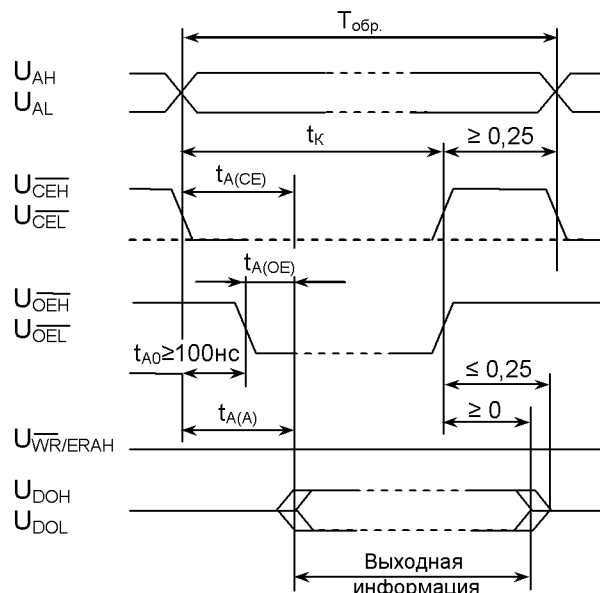
| | |
|---|-----|
| Механические удары, g | 150 |
| Линейное ускорение, g | 500 |
| Вибрация 1 - 2 000 Гц, g | 20 |
| Устойчивость к воде и спирто-бензиновой смеси | 1:1 |

КЛИМАТИЧЕСКИЕ

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Диапазон рабочих температур, °C | от - 10 до 70 |
| Изменение температуры среды, °C | от - 60 до 85 |
| Повышенная влажность при T = 35 °C, % | до 98 |
| Температура пайки, °C | 235 ± 5 |
| Продолжительность, с | 2 ± 0,5 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ($U_{CC} = 5 \text{ В} \pm 5\%$)

| Символ | Параметр | T, °C | K558PP2A | K558PP2Б |
|--------------|---|---------------|-------------------------|-------------------------|
| U_{DOL} | Напряжение выхода низкого уровня, В ($I_{OL} = 1,6 \text{ мА}$) | от -10 до 70 | $\leq 0,4$ | $\leq 0,4$ |
| U_{DOH} | Напряжение выхода высокого уровня, В ($I_{OH} = 0,1 \text{ мА}$) | от -10 до 70 | $\geq 2,4$ | $\geq 2,4$ |
| I_{CC} | Ток потребления, мА | 25, 70 -10 | ≤ 70 ≤ 100 | ≤ 70 ≤ 100 |
| $I_{WR/ERA}$ | Ток сигнала записи, мА | 25 ± 10 | ≤ 30 | ≤ 30 |
| I_{LI} | Ток утечки, мкА | 25 ± 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| $t_{A(A)}$ | Время выборки адреса, мкс | от -10 до 70 | $\leq 0,35$ | $\leq 0,7$ |
| C_{I2} | Входная ёмкость выводов вход-выход, пФ | 25 ± 10 | ≤ 25 | ≤ 25 |
| t_{SG} | Время хранения информации (при включённом или отключённом питании), ч | от -10 до 70 | $\geq 5\ 000$ | $\geq 5\ 000$ |
| N_{CY} | Количество циклов перепрограммирования, цикл | 25 ± 10 | $\geq 10\ 000$ | $\geq 10\ 000$ |

ДИАГРАММА РЕЖИМА ЗАПИСИ

ДИАГРАММА РЕЖИМА СЧИТЫВАНИЯ


$T_{обр}$ – период обращения (тактовый интервал);
 t_K – время поддержания контролируемого состояния;
 t_{AO} – время задержки.

Длительность сигнала записи-стирания: при стирании ($1 \pm 0,1$)с, при записи ($10 \pm 0,5$)мс.

Имеется возможность:

- расширения температурного диапазона от минус 60 до 85 °C;
- распространения требований стойкости к спецвоздействиям;
- перепрограммирования микросхем в диапазоне температур.